ヰ　厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜するように設計した装置　［新設］

ノ　タングステンの膜（ふっ素の原子数が一立方センチメートル当たり一〇の一九乗未満のものに限る。）を、プラズマを用いた原子層堆積法又は化学的気相成長法により成膜するように設計した装置（レ（二）に該当するものを除く。）　［新設］

オ　金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、深さが五〇ナノメートル超のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置　［新設］

ク　〇・〇一パスカル以下の真空状態において稼働するアニール装置であって、次のいずれかに該当するもの　［新設］

（一）　銅のリフローを実施することにより、銅配線の空隙又は継ぎ目を最小化し、又はなくすことができるもの

（二）　コバルト又はタングステンの充塡金属のリフローを実施することにより、空隙又は継ぎ目を最小化し、又はなくすことができるもの

ヤ　〇・〇一パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ、銅の成膜を可能にするように設計した装置　［新設］

マ　複数のチャンバー又はステーションを有する装置であって、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したもの（ウに該当するものを除く。）　［新設］

ケ　ウエハーの表面改質の後に乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置　［新設］

フ　極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスクブランク又は当該装置用のパターン付きのマスクを検査するように設計した装置　［新設］

十七の二　ペリクルであって、極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したもの　［新設］

十七の三　［略］

十八～二十四　［略］

第十九条　［略］

2　外為令別表の七の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌからフまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

3～5　［略］

備考　表中の［　］は注記である。

十七の二　［略］

十八～二十四　［略］

第十九条　［略］

2　外為令別表の七の項（二）の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。

3～5　［略］

附　則

この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。